

日程表 (会場別) 1

中部大学

| 会場名 | 収容数 | 9月2日 (火) | | 9月3日 (水) | | 9月4日 (木) | | 9月5日 (金) | | | |
|------|---------------|----------|------------------------|---|--------------------------------|--|-----------------------------|--|---|----------------------|-----------|
| | | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | | |
| 9号館 | A 2F-921 | 105 | 17.3 新技術 | 17.3 新技術 17.4 トライボロジー | 17.5 エネルギー変換・貯蔵 17.6 資源・環境 | 「応用物理教育分科会企画「ものづくり人材育成および理科教育の地域の取組みとその活性化～東海地区～」 | 8.2 プラズマ診断・計測 | 「重力応用研究グループ企画「重力場応用研究」 | 17.1 応用物理一般 | 17.1 応用物理一般 | |
| | B 2F-922 | 105 | 9.1 誘電材料・誘電体 | 9.5 新機能材料・新物性 9.1 誘電材料・誘電体 | 1.1 放射線物理一般・検出器基礎 | 「放射線分科会企画「放射線スペクトロスコピーの最前線」 | 1.1 放射線物理一般・検出器基礎 | 「放射線分科会企画「高エネルギーイオンビームを用いたナノ・マイクロ構造創製技術とそその応用」 | 17.7 磁場応用 | 17.7 磁場応用 | |
| | D 2F-924 | 105 | 7.6 イオンビーム一般 | 7.6 イオンビーム一般 | 7.5 ビーム・光励起表面反応 | | | 8.4 プラズマエッチング | 1.3 放射線応用・新技術 | | |
| | E 2F-925 | 184 | 13.6 Siデバイス/集積化技術 | 13.6 Siデバイス/集積化技術 | 13.6 Siデバイス/集積化技術 | 「シリコンナノエレクトロニクス新展開—新材料導入によるシリコンプラットフォームの超機能化—」 | 13.6 Siデバイス/集積化技術 | 13.6 Siデバイス/集積化技術 | 13.6 Siデバイス/集積化技術 | | |
| | F 3F-931 | 105 | | 7.2 電子顕微鏡、評価、測定、分析 | 7.1 X線技術 | 7.1 X線技術 | 7.1 X線技術 7.8 ビーム応用一般・新技術 | 11.5 接合、回路作製プロセスおよびデジタル応用 | 11.5 接合、回路作製プロセスおよびデジタル応用 | | |
| | G 3F-932 | 105 | 13.1 基礎物性・評価 | 13.1 基礎物性・評価 | 13.1 基礎物性・評価 | | | 11.3 臨界電流、超伝導パワー応用 | 11 超伝導特別企画「鉄系高温超伝導体特別セッション」 11.1 基礎物性 | 11.1 基礎物性 | 11.1 基礎物性 |
| | H 3F-935 | 105 | | 12.10 特定テーマ：生体分子計測・バイオナノテクノロジー | 12.10 特定テーマ：生体分子計測・バイオナノテクノロジー | 12.10 特定テーマ：生体分子計測・バイオナノテクノロジー | 9.3 ナノエレクトロニクス | 9.2 微粒子・粉体 9.3 ナノエレクトロニクス | | | |
| | J 3F-936 | 195 | 6.3 酸化物エレクトロニクス | 6.3 酸化物エレクトロニクス | 6.3 酸化物エレクトロニクス | 6.3 酸化物エレクトロニクス | 6.3 酸化物エレクトロニクス | 6.3 酸化物エレクトロニクス | 6.3 酸化物エレクトロニクス | 6.3 酸化物エレクトロニクス | |
| | K 3F-937 | 151 | 6.1 強誘電体薄膜 | 6.1 強誘電体薄膜 | 6.1 強誘電体薄膜 | 6.1 強誘電体薄膜 | 6.1 強誘電体薄膜 | 6.1 強誘電体薄膜 | 「応用電子物性分科会、6.1 強誘電体薄膜、9.1 誘電材料・誘電体共同企画「強誘電体 360度エクスポーラ」 | 6.1 強誘電体薄膜 | |
| | L 3F-938 | 151 | | 「薄膜・表面物理分科会企画「トライボロジー研究の最前線—摩擦の物理と応用—」 | 6.6 プローブ顕微鏡 | 「AFMによるナノ構造物質評価手法標準化の現状と展望—標準試料開発とその応用—」 | 6.6 プローブ顕微鏡 | 6.6 プローブ顕微鏡 | 6.6 プローブ顕微鏡 | 6.6 プローブ顕微鏡 | |
| | M 4F-946 | 252 | 7.4 ナノインプリント | 7.4 ナノインプリント | | 「プラズマエレクトロニクス賞受賞記念講演「リレスプラズマが拓く新しい技術～プロセスから環境・バイオまで」 | 12.4 光機能材料・デバイス | 「有機結晶はどこまで進化するか？(有機結晶成長の最新動向と光機能の発現)」 | 12.4 光機能材料・デバイス | 12.4 光機能材料・デバイス | |
| | N 4F-947 | 195 | 7.7 微小電子源 | 7.7 微小電子源 | 合同セッションK「酸化亜鉛系機能性材料」 | 合同セッションK「酸化亜鉛系機能性材料」 | 合同セッションK「酸化亜鉛系機能性材料」 | 合同セッションK「酸化亜鉛系機能性材料」 | 合同セッションK「酸化亜鉛系機能性材料」 | 合同セッションK「酸化亜鉛系機能性材料」 | |
| | Q 4F-948 | 151 | 6.4 薄膜新材料 | 6.4 薄膜新材料 | 6.4 薄膜新材料 | 6.4 薄膜新材料 | 6.4 薄膜新材料 | 10.1 新物質創生・物性探索 | 10.1 新物質創生・物性探索 | | |
| | R 4F-949 | 151 | 6.5 表面物理・真空 | 6.5 表面物理・真空 | 6.5 表面物理・真空 | 6.5 表面物理・真空 | 6.5 表面物理・真空 | 10.2 スピンデバイス・回路・計測技術 | 10.2 スピンデバイス・回路・計測技術 | 10.2 スピンデバイス・回路・計測技術 | |
| 新5号館 | S 2F-521 | 180 | 14.5 半導体光物性・光デバイス | 14.5 半導体光物性・光デバイス | 14.5 半導体光物性・光デバイス | 14.5 半導体光物性・光デバイス | 14.5 半導体光物性・光デバイス | 14.5 半導体光物性・光デバイス | 14.5 半導体光物性・光デバイス | 14.5 半導体光物性・光デバイス | |
| | T 3F-531 | 180 | 14.5 半導体光物性・光デバイス | 14.5 半導体光物性・光デバイス | 12.6 高分子・ソフトマテリアル | 12.6 高分子・ソフトマテリアル | 12.7 生物・医用工学・バイオチップ | 12.7 生物・医用工学・バイオチップ | 12.7 生物・医用工学・バイオチップ | 12.7 生物・医用工学・バイオチップ | |
| 15号館 | V 1F-1511 | 164 | 4.2 フォトニックナノ構造・現象 | 4.2 フォトニックナノ構造・現象 | 4.2 フォトニックナノ構造・現象 | 4.2 フォトニックナノ構造・現象 | 4.7 レーザー・プロセッシング | 4.7 レーザー・プロセッシング | 4.7 レーザー・プロセッシング | | |
| | W 1F-1512 | 164 | 12.8 有機EL | 12.8 有機EL | 12.8 有機EL | 12.3 電子機能材料・デバイス | 12.3 電子機能材料・デバイス | 12.3 電子機能材料・デバイス | | | |
| | X 2F-1521 | 324 | 「カーボンナノチューブナノエレクトロニクス」 | 「カーボンナノチューブナノエレクトロニクス」 | 12.9 有機トランジスタ | 「塗布有機トランジスタの現状と課題」 | 12.9 有機トランジスタ | 12.9 有機トランジスタ | 12.9 有機トランジスタ | | |
| 30号館 | Y 1F-3011 | 214 | 13.3 絶縁膜技術 | 「ユビキタス世界を支えるLSIデバイスの信頼性物理—信頼性を損なうのはだれだ？なぜか？—」 | 9.4 熱電変換 | 9.4 熱電変換 | 8.1 プラズマ生成・制御 | 「人材育成・男女共同参画委員会、刊行委員会、JJAP編集運営委員会共同企画「学会における若手人材育成—応用があなたのキャリアデザインを応援しましょう—」 | | | |
| | ZA 1F-5011 | 246 | 4.3 レーザー装置・材料 | 4.3 レーザー装置・材料 | 4.3 レーザー装置・材料 | 4.3 レーザー装置・材料 | 14.1 探索的材料物性 | 「再生可能サイクルへ向けたエネルギーデバイスの現状」 | | | |
| 51号館 | ZB 2F-5121 | 225 | 4.5 テラヘルツ全般・非線型光学 | 「THz電磁波技術研究会企画「高強度テラヘルツ波光源開発の最先端」 | 4.4 超高速・高強度レーザー | 「薄膜シリコン太陽電池の開発現状と新技術」 | 4.4 超高速・高強度レーザー | 「ランダム系フォトレクトロニクス研究会企画「光結晶化・相変化」 | | | |

日程表 (会場別) 2

中部大学

| 会場名 | 収容数 | 9月2日 (火) | | 9月3日 (水) | | 9月4日 (木) | | 9月5日 (金) | | |
|--------------|---------------|------------------------------------|---|---|--|--|---|---|----------------------------|----------------------------|
| | | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
| 51号館 | ZC 2F-5122 | 123 | 8.5 プラズマナノテクノロジー | 8.1 プラズマ生成・制御 | 8.4 プラズマエッチング | | 16.2 プロセス技術 | 16.2 プロセス技術 16.3 デバイス | 合同セッションD「プラズマCVDの基礎と応用」 | |
| | ZD 2F-5123 | 120 | 8.6 プラズマ現象・新応用・融合分野 | 8.6 プラズマ現象・新応用・融合分野 | 5.2 光記録 | 5.2 光記録 | 16.1 基礎物性・評価 | 16.1 基礎物性・評価 | 4.1 量子光学・原子光学 | |
| | ZE 3F-5131 | 120 | 4.6 レーザー分光応用・計測 | 4.6 レーザー分光応用・計測 | 4.5 テラヘルツ全般・非線型光学 | 4.5 テラヘルツ全般・非線型光学 | 4.5 テラヘルツ全般・非線型光学 | 4.5 テラヘルツ全般・非線型光学 | 4.5 テラヘルツ全般・非線型光学 | |
| | ZF 3F-5132 | 107 | | 3.4 計測光学 | 3.4 計測光学 | 「アト秒量子ダイナミクス」 | 3.5 情報光学 | 8.3 プラズマ成膜・表面処理 | 8.3 プラズマ成膜・表面処理 | |
| | ZG 3F-5133 | 107 | 3.3 機器・デバイス光学 | 2.1 計測・制御技術 | 2.3 計測標準 | 2.3 計測標準 | 3.1 物理光学・光学基礎 | 3.2 材料光学 | | |
| | ZH 3F-5134 | 120 | 3.6 視覚・色彩 3.7 生体・医用光学 | 3.7 生体・医用光学 | 3.9 光学新領域 | 「新分野を切り拓く空間光波面制御技術」 | 3.8 近接場光学 | 3.8 近接場光学 | | |
| 25号館 | ZM 2F-2522 | 90 | 11.2 薄膜、厚膜、テープ作製プロセスおよび結晶成長 | 11.2 薄膜、厚膜、テープ作製プロセスおよび結晶成長 | 11.4 アナログ応用および関連技術 | 11.4 アナログ応用および関連技術 | 5.4 光ファイバー | 5.4 光ファイバー | | |
| | ZN 3F-2534 | 116 | 5.3 光制御 | 5.3 光制御 | 5.3 光制御 | 「フォトリック ICT 研究会企画「フォトリック ICT を支える基盤技術」」 | 5.3 光制御 | 5.3 光制御 | 5.3 光制御 | 5.3 光制御 |
| | ZQ 3F-2535 | 140 | 14.3 プロセス技術・界面制御 | 14.3 プロセス技術・界面制御 | 14.2 超薄膜・量子ナノ構造 | 14.2 超薄膜・量子ナノ構造 | 14.2 超薄膜・量子ナノ構造 | 14.2 超薄膜・量子ナノ構造 | | |
| | ZR 4F-2544 | 113 | 10.1 新物質創生・物性探索 | 10.1 新物質創生・物性探索 | 14.1 探索的材料物性 | 14.1 探索的材料物性 | 「次世代計測基盤技術の開発と応用—中部大学先進計測研究センター研究報告と今後の大学での先進研究の進め方—」 | 「次世代計測基盤技術の開発と応用—中部大学先進計測研究センター研究報告と今後の大学での先進研究の進め方—」 | 合同セッションF「カーボンナノチューブの基礎と応用」 | |
| | ZS 4F-2545 | 180 | スクール「省エネルギー・低環境負荷技術の最前線と将来展望」 | | 合同セッションF「カーボンナノチューブの基礎と応用」 | 合同セッションF「カーボンナノチューブの基礎と応用」 | 合同セッションF「カーボンナノチューブの基礎と応用」 | 合同セッションF「カーボンナノチューブの基礎と応用」 | 合同セッションF「カーボンナノチューブの基礎と応用」 | 合同セッションF「カーボンナノチューブの基礎と応用」 |
| 28号館 | ZT 1F-2811 | 177 | 12.1 作製技術 | 12.1 作製技術 | 12.1 作製技術 | 12.1 作製技術 | 「X線結像光学の最前線」 | 「X線結像光学の最前線」 | 12.5 液晶 | |
| 2号館 | ZV 2F-223 | 231 | 1.1 放射線物理一般・検出器基礎 1.2 放射線発生装置・理工学応用 | 1.1 放射線物理一般・検出器基礎 | | 「窒素添加半導体技術のマイルストーンと新展開」 | | JST Innovation Bridge「医工融合を見据えた学から産へのシーズ発表」 | | |
| 21号館 | CA 1F-2111 | 352 | 15.4 III-V 窒化物結晶 | | 15.4 III-V 窒化物結晶 | 「スピントロニクス研究会企画「半導体へのスピントロニクス注入とデバイス応用への展望」」 | 15.4 III-V 窒化物結晶 | 15.4 III-V 窒化物結晶 | 15.4 III-V 窒化物結晶 | 15.4 III-V 窒化物結晶 |
| | CB 2F-2121 | 141 | 7.3 リソグラフィ | 7.3 リソグラフィ | 13.3 絶縁膜技術 | 13.3 絶縁膜技術 | 13.3 絶縁膜技術 | 13.3 絶縁膜技術 | | |
| | CD 2F-2122 | 141 | | 13.2 半導体表面 | 13.2 半導体表面 | 13.2 半導体表面 | 13.4 配線技術 | 13.4 配線技術 | | |
| 22号館 | CE 1F-2213 | 150 | 15.6 IV 族系化合物 | 15.6 IV 族系化合物 | 15.6 IV 族系化合物 | 15.5 IV 族結晶, IV-IV 族混晶 | 15.7 エピタキシーの基礎 | | 15.8 結晶評価, ナノ不純物・結晶欠陥 | |
| | CF 1F-2214 | 150 | 15.3 III-V 族エピタキシャル結晶 | 「非破壊検査用結晶材料と応用機器」 | 15.3 III-V 族エピタキシャル結晶 | 15.1 バルク結晶成長 | 15.3 III-V 族エピタキシャル結晶 | 15.2 II-VI 族結晶 | | |
| | CG 1F-2215 | 315 | 12.9 有機トランジスタ | | 15.4 III-V 窒化物結晶 | 15.4 III-V 窒化物結晶 | 15.4 III-V 窒化物結晶 | 15.4 III-V 窒化物結晶 | 15.4 III-V 窒化物結晶 | 15.4 III-V 窒化物結晶 |
| | CH 2F-2224 | 150 | 13.5 Si プロセス技術 | 13.5 Si プロセス技術 | 13.5 Si プロセス技術 | 13.5 Si プロセス技術 | 13.5 Si プロセス技術 | 「Poly-Si TFT - 結晶粒界の物理とエンジニアリング-」 | | |
| 三浦幸平メモリアルホール | CJ | 600 | 講演奨励賞贈呈式 論文賞授賞式 フェロー表彰式 | 特別シンポジウム「窒化物半導体高輝度発光デバイス研究の現状とインパクト」 臨時総会 評議員・代議員合同会議 | | | | | | |
| 体育館 | ポスターセッション | 5.1 半導体レーザー・発光/受光素子 6.2 カーボン系薄膜 | <前半> 12.9 有機トランジスタ 15.3 III-V 族エピタキシャル結晶 | 6.2 カーボン系薄膜 10.3 磁気記録媒体・磁気センサー 10.4 光・量子スピントロニクス 17.2 教育 | <前半> 4.4 超高速・高強度レーザー 15.3 III-V 族エピタキシャル結晶 | 2.2 精密計測・ナノ計測 12.2 評価・基礎物性 14.4 超高速・機能デバイス | <前半> 4.4 超高速・高強度レーザー 11.3 臨界電流, 超伝導パワー応用 15.3 III-V 族エピタキシャル結晶 | 12.2 評価・基礎物性 14.4 超高速・機能デバイス | | |
| | | | <後半> 5.1 半導体レーザー・発光/受光素子 6.2 カーボン系薄膜 9.5 新機能材料・新物性 | | <後半> 7.5 ビーム・光励起表面反応 12.2 評価・基礎物性 13.7 シミュレーション | <後半> 3.5 情報光学 8.2 プラズマ診断・計測 | | | | |